



MASTER

Das Wichtigste zum Studiengang

Leistungs- und Mikroelektronik

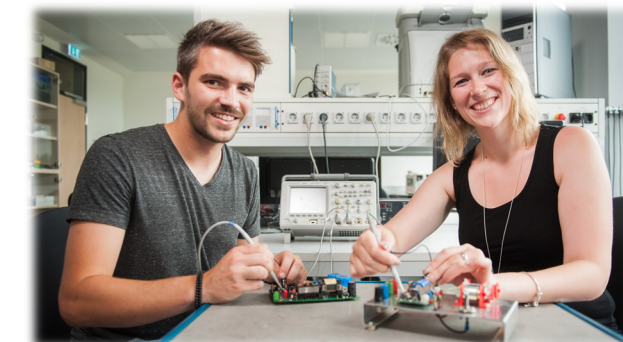
Master of Science

Leistungs- und Mikroelektronik

Die Kombination aus Leistungs- und Mikroelektronik ist der Schlüssel für die großen technischen Aufgaben unserer Zeit wie die E-Mobility oder der Umbau unserer Stromversorgung auf erneuerbare Energien. Auch zukunftsweisende Innovationen in der Medizintechnik, in der Automatisierung (Industrie 4.0) und in der Haustechnik werden durch Leistungs- und Mikroelektronik überhaupt erst möglich.

Der Schwerpunkt des Studiengangs liegt auf dem Entwurf analoger integrierter Schaltkreise und der Leistungselektronik. Diese Schaltungen bilden die Schnittstellen zur Außenwelt, ohne die kein elektronisches System auskommen kann.

Die aktuellen Anforderungen der Industrie bei der Entwicklung von leistungs- und mikroelektronischen Systemen fließen ständig in die Studieninhalte ein.



Eckdaten zum Studiengang

Zulassungsvoraussetzungen	Erfolgreich absolviertes Erststudium der Fachrichtung Elektrotechnik, Elektronik, Mechatronik oder einem vergleichbaren ingenieur- oder naturwissenschaftlichen Studiengang
Zulassungsverfahren	Auswahl nach Durchschnittsnote unter Berücksichtigung weiterer Kriterien (Näheres siehe Website)
Bewerbungsfristen	28.02. für das Sommersemester (SS) 31.08. für das Wintersemester (WS)
Studienbeginn	Sommer- und Wintersemester
Studiendauer	3 Semester
Studienmodelle	Studium in Vollzeit oder in Teilzeit möglich
Auslandssemester	Optional (falls gewünscht)
Anzahl der Studienplätze	Sommersemester: 15 Wintersemester: 15
Abschluss	Master of Science (M. Sc.)
Kosten pro Semester	Studentenwerks- und Verwaltungskostenbeitrag (Näheres siehe Website)

Hochschule Reutlingen
Fakultät Technik
Alteburgstraße 150
72762 Reutlingen
le@reutlingen-university.de
Telefon 07121 271-7038 o. 7085
Fax 07121 271-7140

www.tec.reutlingen-university.de
www.electronics-and-drives.de



Stand: 05/2022



„Der Masterstudiengang Leistungs- und Mikroelektronik vermittelt Kernkompetenzen, die wichtige und herausfordernde Zukunftsthemen wie Elektrifizierung, Automatisierung und Vernetzung adressieren. Die Absolventen dieses Studiengangs haben eine exzellente Qualität.“

Jens Fabrowsky
Executive Vice President für Automotive Electronics, Robert Bosch GmbH, Reutlingen

2 x 100 W GaN FET Class D HiFi Audio Amplifier

Labels on the board:

- Output Filter Channel 1
- Channel 1 Full-Bridge Output
- 48 V Power Supply Input
- Channel 2 Full-Bridge Output
- Output Filter Channel 2
- EPC2152 ePower Stage GaN FET Halfbridge (1/4)
- EPC2152 ePower Stage GaN FET Halfbridge (4/4)
- 0,35-µm CMOS Asynchronous Delta-Sigma Modulator ASIC
- Stereo Input 3.5 mm TRS

Dimensions: 65 mm x 90 mm

